

КТ684А, КТ684Б, КТ684В, КТ684Г
Кремниевые усилительные р-п-р транзисторы средней мощности

Типовое значение граничной частоты передачи тока $f_{гр} = 40$ МГц (КТ684 А,Б,В); 80 МГц (КТ684 Г)

Максимальная рассеиваемая мощность коллектора $P_{кmax} = 800$ мВт

Максимальное постоянное напряжение коллектор-база $U_{кбmax} = 45$ В (КТ684А); 60В (КТ684Б)

Тип изделия	Номер ТУ	Тип корпуса
КТ684А, КТ684Б, КТ684В, КТ684Г	аА0.336.810 ТУ	КТ-26 (ТО-92)

Кремниевые планарно - эпитаксиальные усилительные р-п-р транзисторы в пластмассовом корпусе с гибкими выводами типа КТ684 могут применяться в усилительных, генераторных и переключающих устройствах аппаратуры широкого применения. Размеры кристалла 0,5 x 0,5 мм.

Маркировка транзисторов соответствует техническим условиям аА0.336.810 ТУ.

Схема расположения выводов
КТ684А, КТ684Б, КТ684В, КТ684Г



- 1 - Эмиттер
- 2 - Коллектор
- 3 - База

КТ-26

Основные электрические параметры при температуре: 0°C ÷ + 70°C

Наименование параметра (режим измерения), единица измерения	Буквенное обозначение	КТ684 по группам			
		А	Б	В	Г
Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером при $U_{кб} = 2$ В, $I_э = 150$ мА не менее не более	$h_{21э}$	40	40	40	180
		250	160	160	400
при $U_{кб} = 2$ В, $I_э = 500$ мА не менее		25			
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер, В при $I_к = 500$ мА, $I_б = 50$ мА не более	$U_{кэнас}$	0,5			
Напряжение насыщения база-эмиттер, В при $I_к = 500$ мА, $I_б = 50$ мА не более	$U_{бэнас}$	1,2			
Обратный ток коллектора, нА при $U_{кб} = 30$ В не более	$I_{кбо}$	100			
Обратный ток коллектора, нА при $U_{эб} = 5$ В не более	$I_{эбо}$	100			
Емкость коллекторного перехода, пФ при $U_{кб} = 10$ В не более	$C_к$	50			



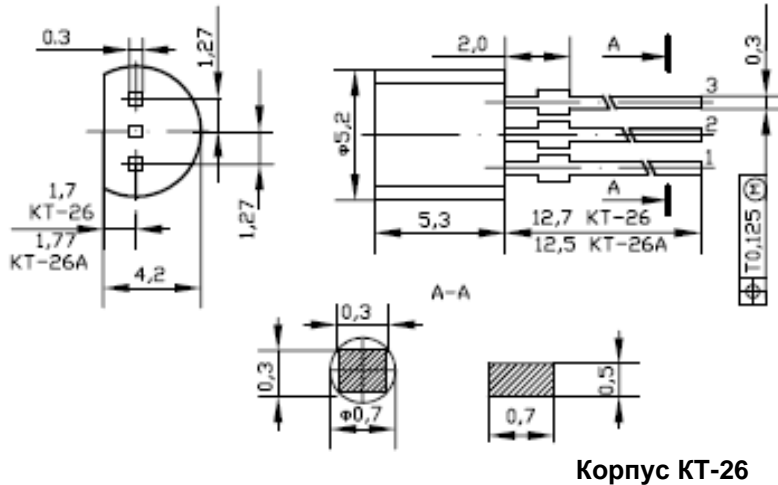
Предельно допустимые режимы эксплуатации

Наименование параметра, единица измерения	Буквенное обозначение	Норма				Примечания
		КТ684А	КТ684Б	КТ684В	КТ684Г	
Максимально допустимое постоянное напряжение коллектор-база, В	$U_{КБ\max}$	45	60	100	30	1
Максимально допустимое постоянное напряжение коллектор-эмиттер при $I_K=10\text{ мА}$, $R_{БЭ}=\infty$, В	$U_{КЭ0\max}$	40	60	100	30	1
Максимально допустимое постоянное напряжение эмиттер-база, В	$U_{ЭБ\max}$	5				1
Максимально допустимый постоянный ток коллектора, мА	$I_{K\max}$	1000				1
Максимально допустимая рассеиваемая мощность коллектора, мВт до $T=+25\text{ }^\circ\text{C}$	$P_{K\max}$	800				2
Максимально допустимая температура перехода, $^\circ\text{C}$	T_n	150				
Общее тепловое сопротивление, $^\circ\text{C}/\text{Вт}$	$R_{T\text{ п-с}}$	208				

Примечания:

- 1) При условии неперевышения $P_{K\max}$.
- 2) При температуре окружающей среды до $+25\text{ }^\circ\text{C}$. При температуре выше $+25\text{ }^\circ\text{C}$ $P_{K\max}$ рассчитывается по формуле: $P_{K\max} = (150 - T_{\text{окр.ср}}) / R_{T\text{ п-с}}$, Вт.

Габаритные чертежи используемых корпусов



- 1 - База
2 - Коллектор
3 - Эмиттер
Допускается отсутствие выступов на выводах. Позиционный допуск на расстоянии 2,0 мм max.

Корпус КТ-26